

JETPVm 認証における試験基準の変更に伴う経過措置について

太陽電池モジュール認証(JETPVm 認証)サービスにおける〈性能+安全性〉認証 (製品試験適用規格の変更について)

JETPVm 認証は、製品試験の適用基準を平成 18 年 (2006 年) 10 月 1 日から「性能+安全性」認証に変更しました。
これに伴う経過措置は以下のとおりです。

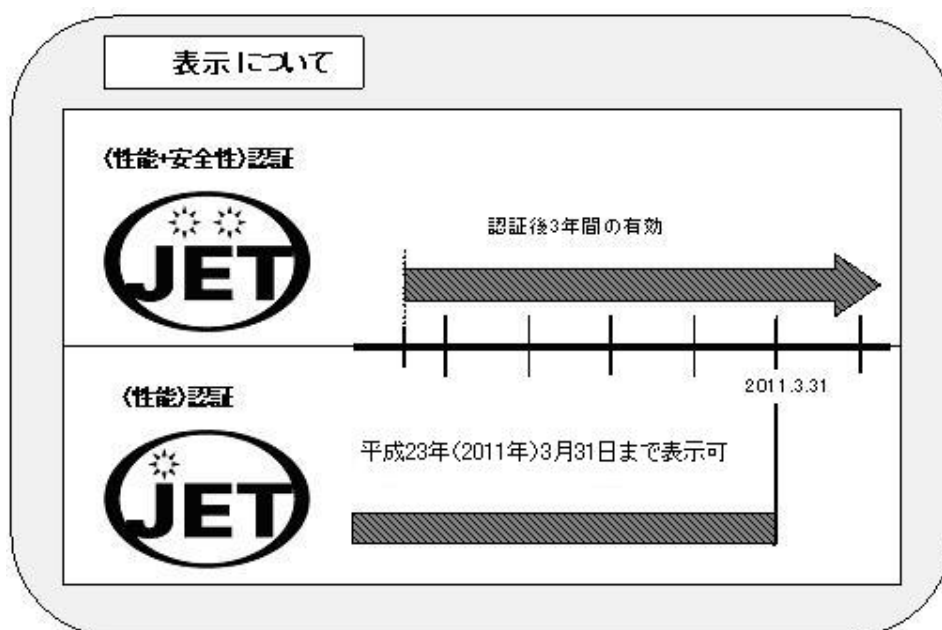
1. 認証マーク



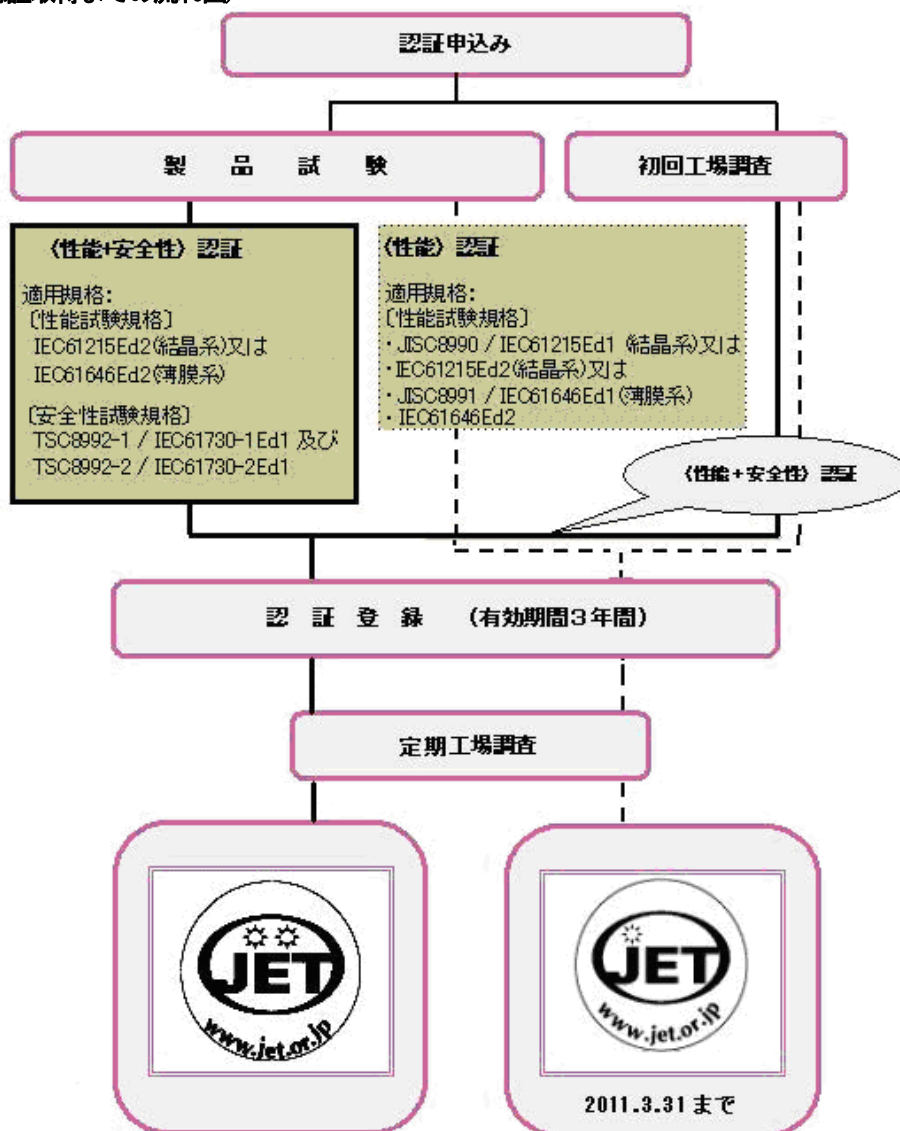
〈性能+安全性〉認証マーク

2. 旧認証マークの取扱いについて

- ・平成 20 年 (2008 年) 3 月 31 日までに認証を取得しているモデルにあつては、旧来の認証の期限まで製造段階で旧来の表示を行うことができます。
- ・平成 20 年 (2008 年) 4 月 1 日以降、旧来の性能だけの製品試験基準を適用して認証されたモデルの有効期限は、平成 23 年 (2011 年) 3 月 31 日までとします。平成 23 年 (2011 年) 4 月 1 日以降は、製造段階において旧来の表示を行うことができなくなります。



(認証取得までの流れ図)



(参考) 新旧適用試験規格

◎ 新規格

試験基準は、【<性能+安全性> 認証】とします。

性能認証試験規格と安全性認証試験規格が適用されます。

【性能認証試験規格】

〔結晶シリコン太陽電池(PV)モジュール〕

- ・ IEC61215 Ed.2 (2005 年)

(Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval)

〔薄膜太陽電池(PV)モジュール〕

- ・ IEC61646 Ed.2 (2008 年)

(Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval)

【安全性認証試験規格】

- ・ TSC8992-1(2006年)(IEC61730-1 Ed.1 2004年)
(太陽電池(PV)モジュールの安全性適合認定-第1部：構造に対する要求事項
及び
- ・ TSC8992-2(2006年)(IEC61730-2 Ed.1 2004年)
(太陽電池(PV)モジュールの安全性適合認定-第2部：試験に関する要求事項)

◎ 旧規格（平成21年(2009年)3月31日(火)までの間、暫定的に受付中）

【性能認証】

〔結晶シリコン太陽電池(PV)モジュール〕

- ・ JISC8990(2004年)(IEC61215 Ed.1 1993年)
(地上設置の結晶シリコン太陽電池(PV)モジュール-設計適格性確認及び形式認証
のための要求事項)

又は

- ・ IEC61215 Ed.2 (2005年)
(Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
qualification and type approval)

〔薄膜太陽電池(PV)モジュール〕

- ・ JISC8991(2004年)(IEC61646 Ed.1 1996年)
(地上設置の薄膜太陽電池(PV)モジュール-設計適格性確認及び形式認証のための
要求事項)

又は

- ・ IEC61646 Ed.2 (2008年)
(Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
qualification and type approval)

- * 旧来の性能認証試験規格のみの認証申込みは、平成20年(2008年)3月末をもって、受付をいったん終了
しましたが、産業界からの要望を受け、平成21年(2009年)1月5日(月)から平成21年(2009年)3月31日(火)
までの間、一時再開しています。

(お問い合わせ先)

- ・ (財)電気安全環境研究所 (JET) 研究部
TEL:03-3466-5126 E-mail: pvm@jet.or.jp